

THEOREME DE GAUSS

OBJECTIF :

Nous avons vu dans les chapitres précédents différentes façons de **déterminer le champ électrostatique \vec{E}** via la **loi de coulomb** (pour tout type de distribution de charges) ou à partir **du potentiel V** (d'après la formule : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V}$).

Le **théorème de Gauss** permet également de **déterminer le champ \vec{E}** créé par **des distributions de charges possédant un haut degré de symétries** (fil infini, plan infini, sphère...).

I) Enoncé du théorème de Gauss

Le **flux du champ \vec{E}** , noté Φ , créé par une distribution de charges (D), à travers une **surface fermée (S)** est égal à la charge située à **l'intérieur** de

la surface Q_{int} divisé par ϵ_0 :

$$\Phi = \oiint_{M \in (S)} \vec{E}(M) \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

II) Champ créé par une sphère uniformément chargée en volume

A) Méthode de calcul de \vec{E} par le théorème de Gauss

1. *Analyse des invariances et des symétries*
2. *Choix de la surface de Gauss*
3. *Application du théorème de Gauss*

B) Détermination du potentiel

III) Champ créé par un fil rectiligne infini uniformément chargé

A) Calcul de \vec{E} par le théorème de Gauss

1. *Analyse des invariances et des symétries*
2. *Choix de la surface de Gauss*
3. *Application du théorème de Gauss*

B) Détermination du potentiel

IV) Champ créé par un plan infini uniformément chargé

A) Calcul de \vec{E} par le théorème de Gauss

1. *Analyse des invariances et des symétries*
2. *Choix de la surface de Gauss*
3. *Application du théorème de Gauss*

B) Détermination du potentiel

C) Modélisation du condensateur plan